

КТ938Б-2
кремниевый биполярный
эпитаксиально-планарный
п-р-п транзистор

Назначение

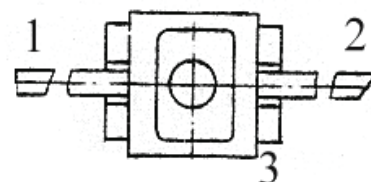
Кремниевый эпитаксиально-планарный п-р-п СВЧ транзистор КТ938Б-2 предназначен применения в схеме с общей базой в усилительных и генераторных устройствах на частоте до 5 ГГц в составе гибридных интегральных микросхем, микромодулях, узлах и блоках аппаратуры широкого применения.

Обозначение технических условий

- аАО.336.003 ТУ

Корпусное исполнение

- бескорпусное исполнение


Назначение выводов

Вывод	Назначение
№1	Эмиттер
№2	Коллектор
№3	База

Таблица 2. Основные электрические параметры КТ938Б-2 при $T_{окр. среды} = (25 \pm 10) ^\circ C$

Параметры	Обозначение	Ед. изм.	Режимы измерения	Min	Max
Обратный ток коллектора	$I_{кбо}$	мА	$U_{кб}=28В$	-	1
Емкость коллекторного перехода*	C_k	пФ	$U_{кб}=20В$ $f=10МГц$	-	4,5
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером	$F_{гр}^*$	Гц	$f=300МГц$ $I_k=150мА$ $U_{кэ}=3В$	1,8	-
Коэффициент усиления по мощности (медианное значение)	$K_{ур}$	дБ	$U_{кб}=20 В$ $f=5ГГц$ $P_{вых}=0,8 Вт$	3	-
Коэффициент полезного действия коллектора (медианное значение)	η_k		$U_{кб}=20 В$ $f=5ГГц$ $P_{вых}=0,8 Вт$	26	-
Обратный ток эмиттера	$I_{эбо}$	мкА	$U_{эб}=2,5 В$	-	100

* справочные параметры

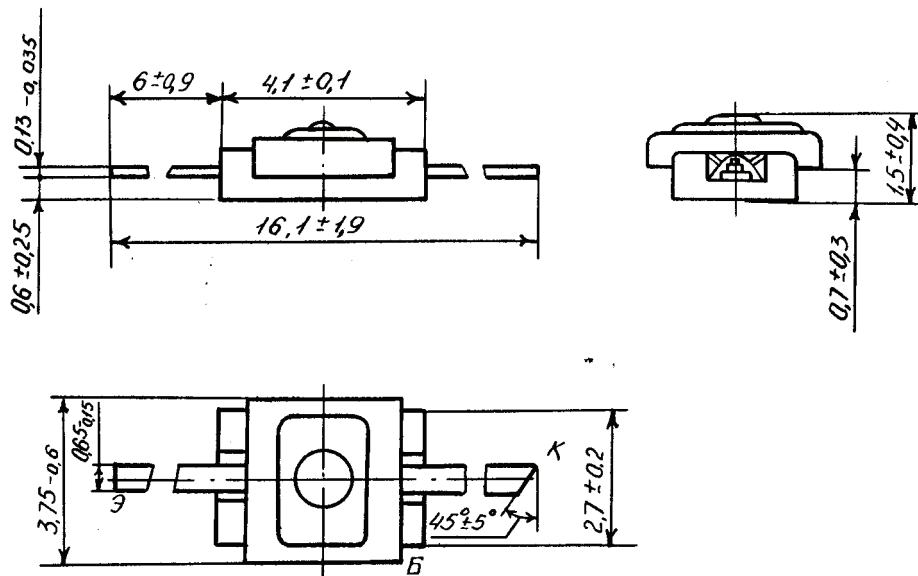


Рисунок 1. Габаритный чертеж КТ938Б-2



ОАО "ИНТЕГРАЛ", г. Минск, Республика Беларусь

Внимание! Данная техническая спецификация является ознакомительной и не может заменить собой утченный экземпляр технических условий или этикетку на изделие.

ОАО "ИНТЕГРАЛ" сохраняет за собой право вносить изменения в описания технических характеристик изделий без предварительного уведомления.

Изображения корпусов приводятся для иллюстрации. Ссылки на зарубежные прототипы не подразумевают полного совпадения конструкции и/или технологии. Изделие ОАО "ИНТЕГРАЛ" чаще всего является ближайшим или функциональным аналогом.

Контактная информация предприятия доступна на сайте:

<http://www.integral.by>